

W53P3C

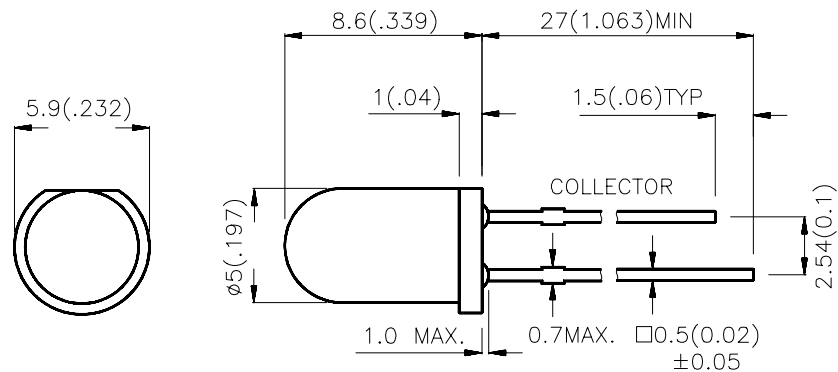
Features

- MECHANICALLY AND SPECTRALLY MATCHED TO THE W53 SERIES INFRARED EMITTING LED LAMP.
- WATER CLEAR LENS.

Description

Made with NPN silicon phototransistor chips.

Package Dimensions



Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.25 (0.01)$ unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the lead emerge package.
4. Specifications are subject to change without notice.

Electrical / Optical Characteristics at $T_A=25^\circ\text{C}$

Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit	Test Condition
$V_{BR\ CE0}$	Collector-to-Emitter Breakdown Voltage	30	-	-	V	$I_C=100\mu\text{A}$ $E_e=0\text{mW}/\text{cm}^2$
$V_{BR\ EC0}$	Emitter-to-Collector Breakdown Voltage	5	-	-	V	$I_E=100\mu\text{A}$ $E_e=0\text{mW}/\text{cm}^2$
$V_{CE\ (SAT)}$	Collector-to-Emitter Saturation Voltage	-	-	0.8	V	$I_C=2\text{mA}$ $E_e=20\text{mW}/\text{cm}^2$
I_{CEO}	Collector Dark Current	-	-	100	nA	$V_{CE}=10\text{V}$ $E_e=0\text{mW}/\text{cm}^2$
T_R	Rise Time (10% to 90%)	-	3	-	us	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_C=1\text{mA}$ $R_L=1000\Omega$
T_F	Fall Time (90% to 10%)	-	3	-	us	
$I_{(ON)}$	On State Collector Current	0.1	0.5	-	mA	$V_{CE}=5\text{V}$ $E_e=1\text{mW}/\text{cm}^2$ $\lambda=940\text{nm}$

Absolute Maximum Ratings at $T_A=25^\circ\text{C}$

Parameter	Maximum Rating
Collector-to-Emitter Breakdown Voltage	30V
Emitter-to-Collector Breakdown Voltage	5V
Power Dissipation at (or below) 25°C Free Air Temperature	100mW
Operating Temperature Range	$-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	$-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$
Lead soldering Temperature (>5mm for 5sec)	260°C

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А